

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДУБЛИКАТ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2610388

Способ одновременного получения р-і-п структуры GaAs, имеющей р, і и п области в одном эпитаксиальном слое

Патентообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "Ме Га Эпитех" (RU)*

Авторы: *Крюков Виталий Львович (RU), Крюков Евгений Витальевич (RU), Меерович Леонид Александрович (RU), Стрельченко Сергей Станиславович (RU), Титивкин Константин Анатольевич (RU), Николаенко Александр Михайлович (RU)*

Заявка № 2015112975

Приоритет изобретения 09 апреля 2015 г.

Дата государственной регистрации в
Государственном реестре изобретений
Российской Федерации 09 февраля 2017 г.

Срок действия исключительного права
на изобретение истекает 09 апреля 2035 г.

Дубликат выдан Федеральной службой
по интеллектуальной собственности 01.02.2018

Руководитель

Г.П. Ивлиев

